



DATASHEET

SI4459BDY-T1-GE3

Giới thiệu	MOSFET P-CHAN 30V SO-8	
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

SI4459BDY-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI4459BDY-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SI4459BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	SI4459BDY-T1-GE3	Thông tin sản phẩm	MOSFET P-CHAN 30V SO-8
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Gói / Trường hợp	Cut Tape (CT)	VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Tối đa)	+20V, -16V	Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	8-SO	Loại	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, VGS	4.9 mOhm @ 15A, 10V	Điện cực phân tán (Max)	3.1W (Ta), 5.6W (Tc)
Bao bì	Cut Tape (CT)	Gói / Case	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Vài cái tên khác	SI4459BDY-T1-GE3CT	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	32 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	3490pF @ 15V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Loại FET	P-Channel	Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V



Xả để nguồn điện áp (Vdss)	30V	miêu tả cụ thể	P-Channel 30V 20.5A (Ta), 27.8A (Tc) 3.1W (Ta), 5.6W (Tc) Surface Mount 8-SO
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	20.5A (Ta), 27.8A (Tc)	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. [Các mô-đun điều khiển năng lượng](#)
2. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn](#)
3. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng](#)
4. [Diode - Bộ chỉnh lưu cầu](#)
5. [Điốt - điện dung biến thiên \(Varicaps, Varactors\)](#)
6. [Điốt - RF](#)
7. [Điốt - Zener - Đơn](#)
8. [Điốt - Zener - mảng](#)
9. [Thyristor - DIACs, SIDACs](#)
10. [Thyristor - SCR](#)
11. [Thyristor - SCRs - Các mô-đun](#)
12. [Thyristor - TRIAC](#)
13. [Transistors - FETs, MOSFETs - RF](#)
14. [Transistors - lưỡng cực \(BJT\) - RF](#)
15. [Transistors - Mục đích đặc biệt](#)
16. [Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn](#)
17. [Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng](#)
18. [Transistor - IGBT - Đơn](#)
19. [Transistor - IGBT - Mảng](#)
20. [Transistor - IGBTs - Các mô-đun](#)
21. [Transistor - JFETs](#)
22. [Transistor - Lập trình Unijunction](#)
23. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn](#)
24. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn, Pre-Biased](#)
25. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng](#)
26. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng, Pre-Biased](#)